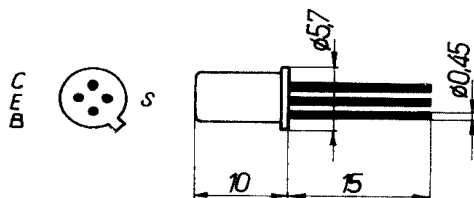


Germanium - pnp - Legierungs - Diffusions - Transistor der Bauform A 4/15 - 4b nach TGL 11 811 für UKW-Mischstufen.



Masse ca. 0,6 g

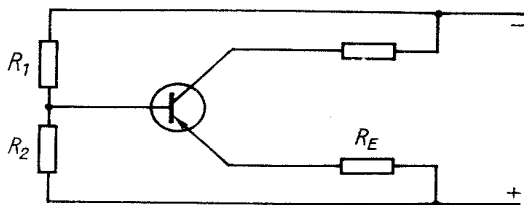
Wärmewiderstand

$$R_{thja} \leq 0,6 \text{ grd/mW}$$

Grenzwerte; gültig für den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CB0}$	= 25 V
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CER}^{1)}$	= 20 V
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO}$	= 0,5 V
Gesamtverlustleistung	P_V	= 80 mW bei $\theta_a = 25^\circ\text{C}$
Kollektorstrom	$-I_C$	= 10 mA
Emitterstrom	I_E	= 11 mA
Basisstrom	$-I_B$	= 1 mA
Sperrschichttemperatur	θ_I	= 75 °C
Betriebstemperaturbereich		-25 °C bis +65 °C

1) bei $R_B/R_E \leq 100$ mit $R_B = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$



Statische Kennwerte

		Min.	Typ	Max.
Kollektor-Basis-Reststrom	$-I_{CB0}$		2 μA	7,5 μA
$-U_{CB} = 6 \text{ V}$				
Kollektor-Basis-Reststrom	$-I_{CB0}$			100 μA
$-U_{CB} = 25 \text{ V}$				
Emitter-Basis-Reststrom	$-I_{EBO}$			100 μA
$-U_{EB} = 0,5 \text{ V}$				
Kollektor-Basis-Stromverhältnis	h_{21E}	40		
$-U_{CE} = 6 \text{ V}$				
$-I_C = 1 \text{ mA}$				

Dynamische Kennwerte

Oszillatorspannung	U_{osz}	140 mV	300 mV
$-U_{CB} = 7 \text{ V}$			
$-I_C = 1,5 \text{ mA}$			
$f = 100 \text{ MHz}$			
Oszillatorspannung	U_{osz}	120 mV	
$-U_{CB} = 5,5 \text{ V}$			
$-I_C = 0,9 \text{ mA}$			
$f = 100 \text{ MHz}$			

Vierpolparameter

$-U_{CB} = 6 \text{ V}$	g_{11b}	21 mS
$-I_C = 1,5 \text{ mA}$	$-b_{11b}$	10 mS
$f = 100 \text{ MHz}$	$-C_{11b}$	14,4 pF
	$ y_{12b} $	0,29 mS
	$-\varphi_{12b}$	130 °
	$ y_{21b} $	13 mS
	φ_{21b}	110 °
	g_{22b}	0,37 mS
	b_{22b}	1,5 mS
	C_{22b}	2,5 pF

Mischleistungsverstärkung

$-U_{CB} = 7 \text{ V}$	G_{pc}	11 dB	16 dB
$-I_C = 1,5 \text{ mA}$			
$f = 100 \text{ MHz}$			

Siehe Meßschaltung Seite

Bestellbeispiel für einen Transistor

Transistor GF 181



